

シングル P チャンネル MOSFET

ELM14419AA-N

<http://www.elm-tech.com>

■概要

ELM14419AA-N は低入力容量、低電圧駆動、低オン抵抗という特性を備えた大電流 MOS FET です。

■特長

- ・ Vds=-30V
- ・ Id=-9.7A (Vgs=-10V)
- ・ Rds(on) < 20mΩ (Vgs=-10V)
- ・ Rds(on) < 35mΩ (Vgs=-4.5V)

■絶対最大定格値

特に指定なき場合、Ta=25℃

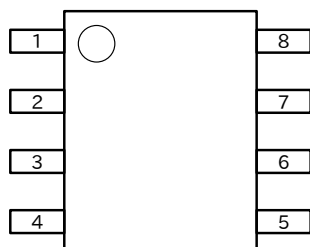
項目	記号	規格値	単位	備考	
ドレイン - ソース電圧	Vds	-30	V		
ゲート - ソース電圧	Vgs	±20	V		
連続ドレイン電流	Id	Ta=25℃	-9.7	A	1
		Ta=70℃	-8.1		
パルス・ドレイン電流	Idm	-40	A	2	
最大許容損失	Pd	Tc=25℃	3.0	W	1
		Tc=70℃	2.1		
接合温度範囲及び保存温度範囲	Tj, Tstg	-55 ~ 150	℃		

■熱特性

項目	記号	Typ.	Max.	単位	備考
最大接合部 - 周囲温度	Rθja	31	40	℃/W	1
最大接合部 - 周囲温度					
最大接合部 - リード	Rθjl	21	30	℃/W	3

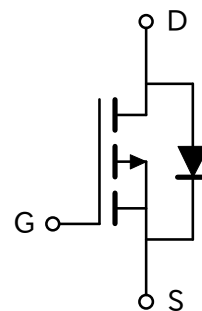
■端子配列図

SOP-8(TOP VIEW)



端子番号	端子記号
1	SOURCE
2	SOURCE
3	SOURCE
4	GATE
5	DRAIN
6	DRAIN
7	DRAIN
8	DRAIN

■回路



シングル P チャンネル MOSFET

ELM14419AA-N

<http://www.elm-tech.com>

■電気的特性

特に指定なき場合、 $T_a=25^\circ\text{C}$

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
静的特性						
ドレイン・ソース降伏電圧	BVdss	$I_d=-250\mu\text{A}$, $V_{gs}=0\text{V}$	-30			V
ゼロ・ゲート電圧ドレイン電流	Idss	$V_{ds}=-24\text{V}$ $V_{gs}=0\text{V}$			-1	μA
		$T_a=55^\circ\text{C}$			-5	
ゲート漏れ電流	Igss	$V_{ds}=0\text{V}$, $V_{gs}=\pm 20\text{V}$			± 100	nA
ゲート・スレッシュホールド電圧	Vgs(th)	$V_{ds}=V_{gs}$, $I_d=-250\mu\text{A}$	-1.4	-2.0	-2.7	V
オン状態ドレイン電流	I _{d(on)}	$V_{gs}=-10\text{V}$, $V_{ds}=-5\text{V}$	-40			A
ドレイン・ソースオン状態抵抗	R _{ds(on)}	$V_{gs}=-10\text{V}$ $I_d=-9.7\text{A}$		16.0	20.0	m Ω
		$T_a=125^\circ\text{C}$		20.9	26.0	
		$V_{gs}=-4.5\text{V}$, $I_d=-7\text{A}$		26.0	35.0	
順方向相互コンダクタンス	G _{fs}	$V_{ds}=-5\text{V}$, $I_d=-9.7\text{A}$		21.7		S
ダイオード順方向電圧	V _{sd}	$I_s=-1\text{A}$, $V_{gs}=0\text{V}$		-0.7	-1.0	V
最大寄生ダイオード連続電流	I _s				-1.2	A
動的特性						
入力容量	C _{iss}			1573	1900	pF
出力容量	C _{oss}	$V_{gs}=0\text{V}$, $V_{ds}=-15\text{V}$, $f=1\text{MHz}$		319		pF
帰還容量	C _{rss}			211		pF
ゲート抵抗	R _g	$V_{gs}=0\text{V}$, $V_{ds}=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$		6.7	8.0	Ω
スイッチング特性						
総ゲート電荷 (10V)	Q _g			26.4	32.0	nC
総ゲート電荷 (4.5V)	Q _g	$V_{gs}=-10\text{V}$, $V_{ds}=-15\text{V}$		13.7	17.0	nC
ゲート・ソース電荷	Q _{gs}	$I_d=-9.7\text{A}$		3.8		nC
ゲート・ドレイン電荷	Q _{gd}			6.8		nC
ターン・オン遅延時間	t _{d(on)}			9.5		ns
ターン・オン立ち上がり時間	t _r	$V_{gs}=-10\text{V}$, $V_{ds}=-15\text{V}$		8.0		ns
ターン・オフ遅延時間	t _{d(off)}	$R_L=1.5\Omega$, $R_{gen}=3\Omega$		44.2		ns
ターン・オフ立ち下がり時間	t _f			22.2		ns
寄生ダイオード逆回復時間	t _{rr}	$I_f=-9.7\text{A}$, $dI_f/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		25.2	31.0	ns
寄生ダイオード逆回復電荷量	Q _{rr}	$I_f=-9.7\text{A}$, $dI_f/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		14.1		nC

備考：

1. $R_{\theta ja}$ の値は $T_a=25^\circ\text{C}$ 、2 オンス銅箔付き FR-4 基板上にマウントされた装置を使用して測定されています。またアプリケーションに付与される値は使用者のボードデザインに依存し、電流定格は $t \leq 10\text{s}$ の熱抵抗定格に基づいています。
2. 接合部温度は反復定格及びパルス幅を制限します。
3. $R_{\theta ja}$ は接合部 - リード間と接合部 - 周囲間の温度インピーダンスの合計です。
4. 標準特性図 1 ~ 6 は $80\mu\text{s}$ パルス・デューティ比最大 0.5% 条件下で得られます。
5. これらの値は $T_a=25^\circ\text{C}$ 、2 オンス銅箔付き FR-4 基板上にマウントされた装置を使用して測定されています。SOA のグラフはパルス定格を規定しています。

シングル P チャンネル MOSFET

ELM14419AA-N

<http://www.elm-tech.com>

■標準特性と熱特性曲線

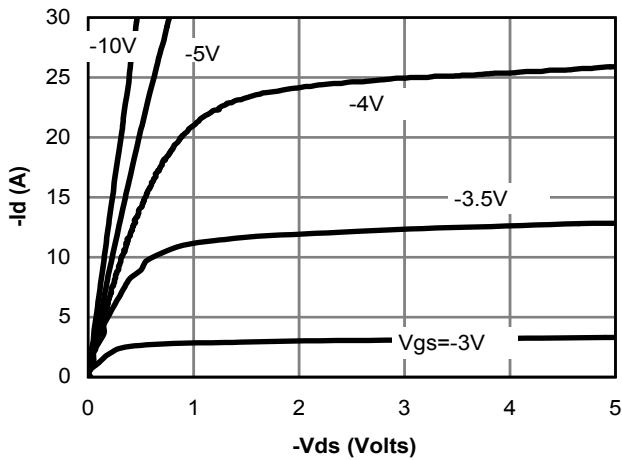


Fig 1: On-Region Characteristics

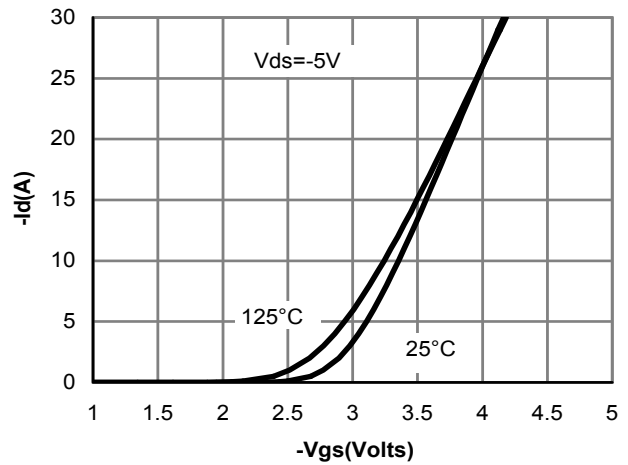


Figure 2: Transfer Characteristics

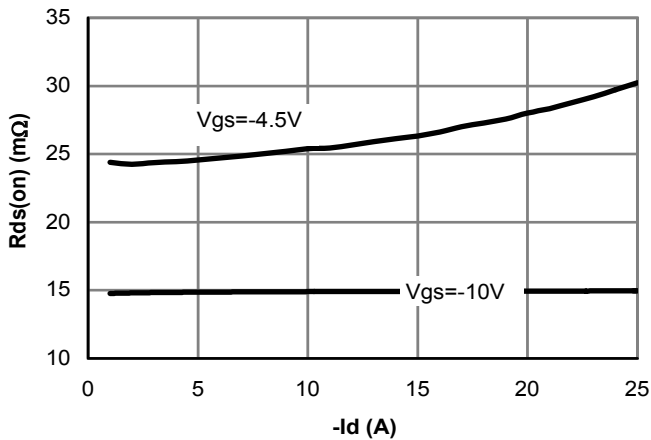


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

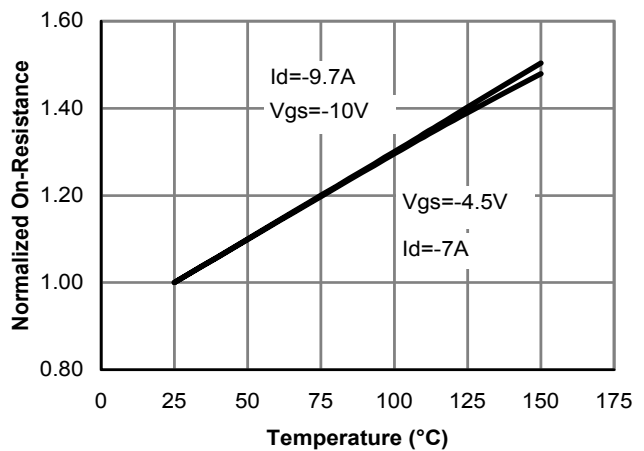


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature

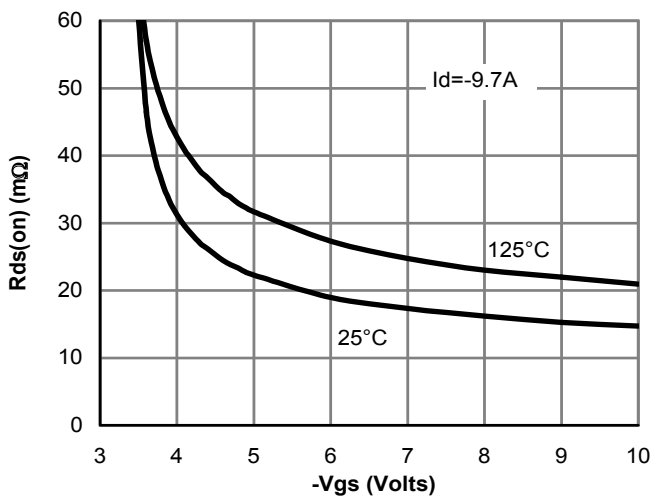


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

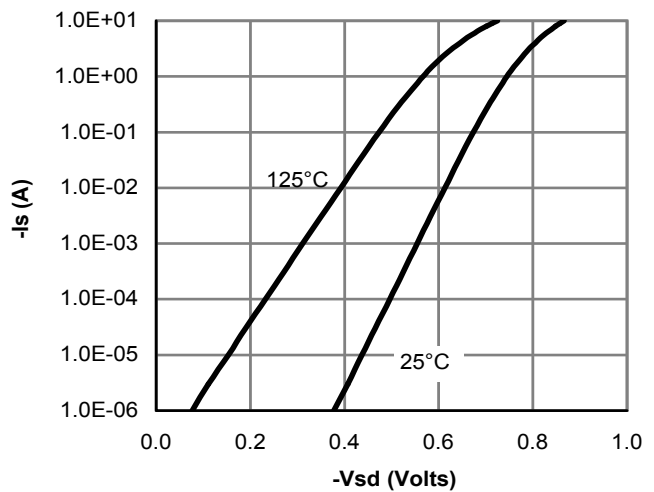


Figure 6: Body-Diode Characteristics

シングル P チャンネル MOSFET

ELM14419AA-N

<http://www.elm-tech.com>

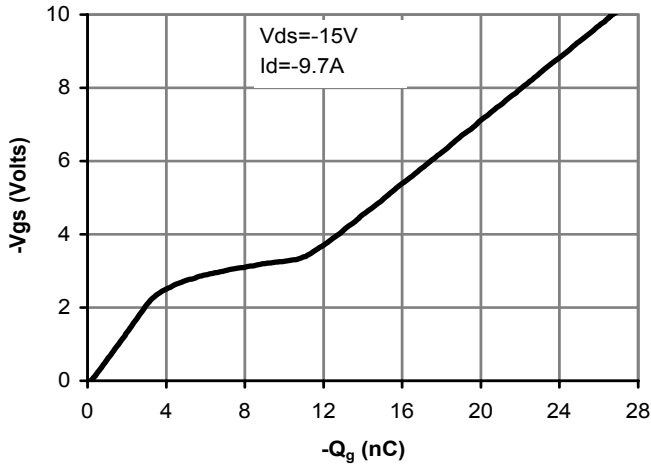


Figure 7: Gate-Charge Characteristics

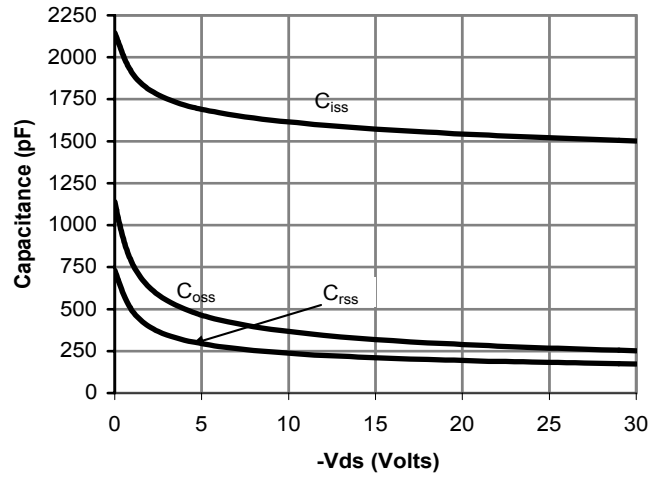


Figure 8: Capacitance Characteristics

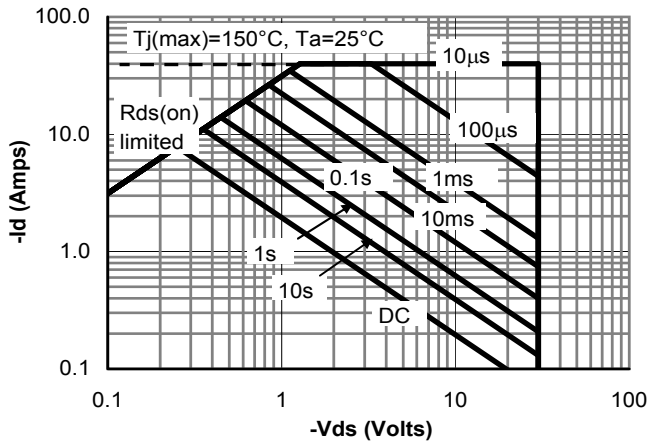


Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area (Note 5)

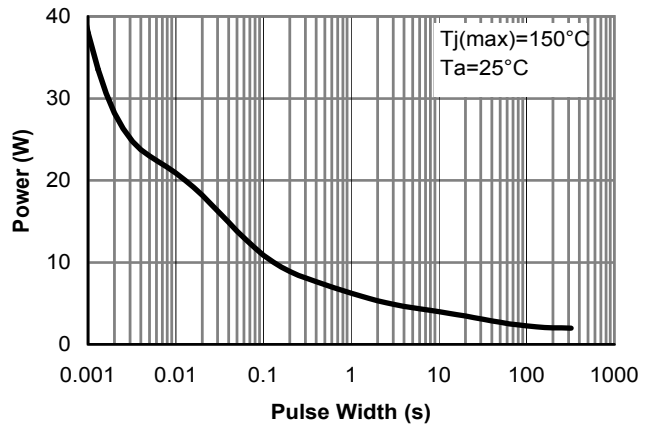


Figure 10: Single Pulse Power Rating Junction-to-Ambient (Note 5)

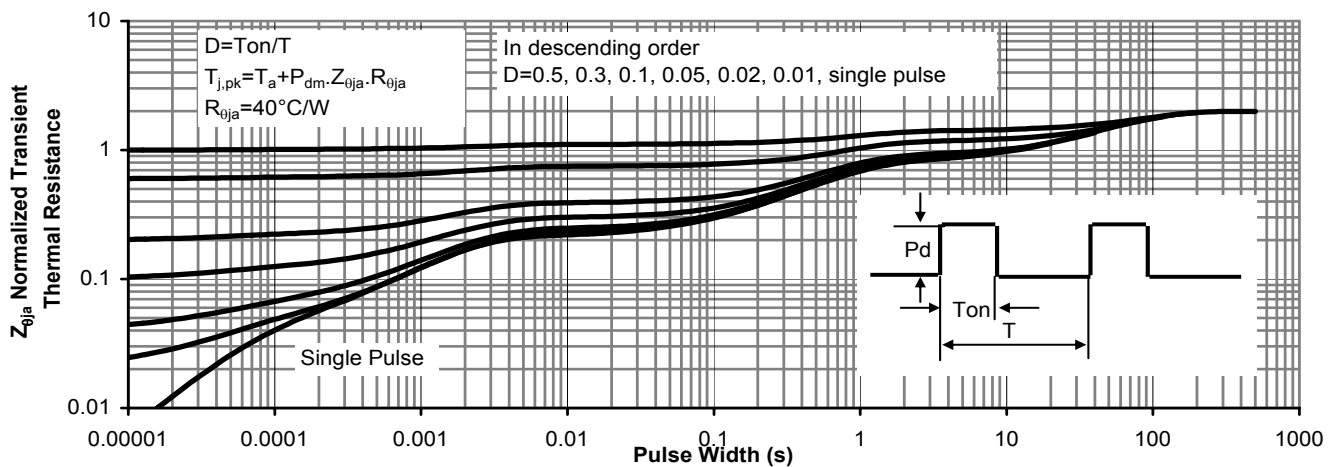


Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance